

D2SB60

600V 1.5A

特長

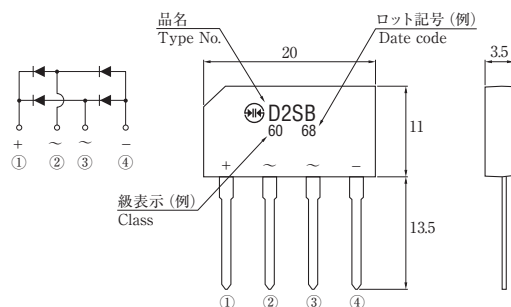
- ・薄型 SIP パッケージ
- ・高 I_{FSM}

Feature

- ・Thin-SIP
- ・Large I_{FSM}

■外観図 OUTLINE

Package : 2S

Unit : mm
Weight : 2.0g (typ.)

外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

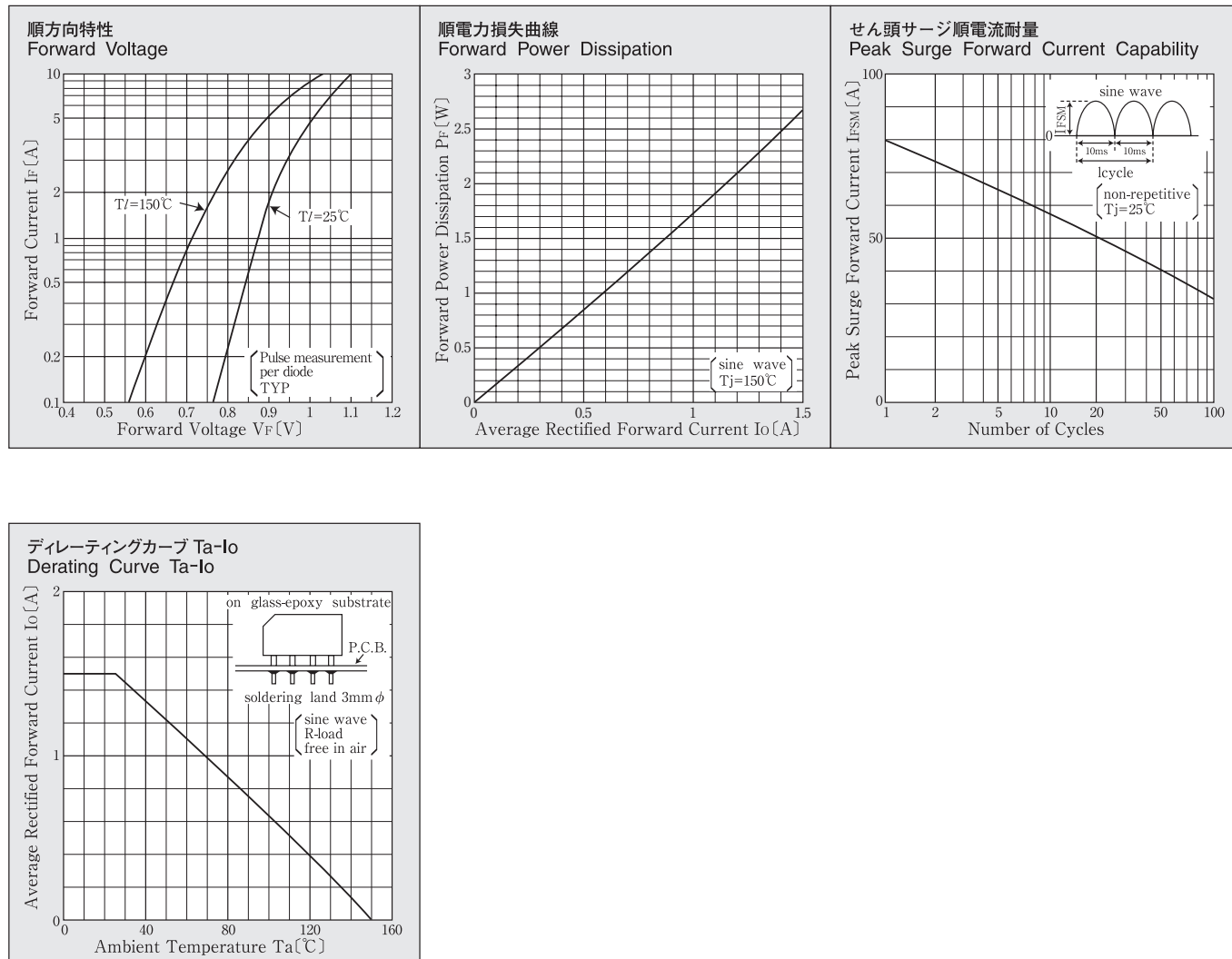
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D2SB60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-40~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, プリント基板実装, $T_a = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, On glass-epoxy substrate, $T_a = 25^\circ\text{C}$		1.5	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		80	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I^2t	$2\text{ms} \leq t < 10\text{ms}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$		32	A^2s

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 0.75\text{A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 10	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	MAX 47	

特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.